

RECTIFICĂRI

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2020/1749 al Comisiei din 7 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 421 din 14 decembrie 2020)

1. La pagina 94, punctele 2B206.c.1 și 2B206.c.2 se citesc astfel:
 - „1. conțin un «laser»; și
 2. sunt capabile să mențină, timp de cel puțin 12 ore, la o temperatură de ± 1 K (± 1 °C); în jurul unei temperaturi standard și la o presiune standard, toate caracteristicile următoare:
 - a. o «rezoluție», pe toată scala, de 0,1 μ m sau mai bună; și
 - b. cu o «incertitudine a măsurării» egală sau mai bună (mai mică) de $(0,2 + L/2\ 000)$ μ m (L este lungimea măsurată în mm).”
2. La paginile 142-143, punctele 3B001.f.3 și 3B001.g se citesc astfel:
 - „3. echipamente special concepute pentru executarea măștilor care au toate caracteristicile următoare:
 - a. un fascicul de electroni, de ioni sau «laser» focalizat deflecat; și
 - b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:
 1. o dimensiune a spotului mai mică de 65 nm la lățimea integrală la jumătatea înălțimii maxime (FWHM) și o plasare a imaginii mai mică de 17 nm (medie aritmetică + 3 sigma); sau
 2. neutilizate;
 3. o eroare de suprapunere la nivelul celui de-al doilea strat mai mică de 23 nm (medie + 3 sigma) pe mască;
 4. echipamente concepute pentru prelucrarea dispozitivelor care utilizează metode directe de scriere și care au toate caracteristicile următoare:
 - a. un fascicul de electroni focalizat deflecat; și
 - b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:
 1. o dimensiune minimă a fasciculului mai mică sau egală cu 15 nm; sau
 2. o eroare de suprapunere mai mică de 27 nm (medie + 3 sigma);
 - g. măști și reticule, concepute pentru circuitele integrate menționate la 3A001;”.
3. La paginile 160-161, punctele 5E001.d-5E001.e.2 se citesc astfel:
 - „d. «tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru «dezvoltarea» sau «producția» amplificatoarelor cu «circuite integrate monolitice cu microunde» (Monolithic Microwave Integrated Circuit, «MMIC»), special concepute pentru telecomunicații și având oricare dintre următoarele caracteristici:

Notă tehnică:

În sensul 5E001.d., parametrul putere de ieșire de vârf saturată poate fi denumit, în fișele tehnice ale produsului, și ca putere de ieșire, putere de ieșire saturată, putere maximă de ieșire, putere de ieșire de vârf sau putere de ieșire de vârf de modulație.

 1. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 2,7 GHz și mai mici sau egale cu 6,8 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 15 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:
 - a. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 75 W (48,75 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,7 GHz și mai mică sau egală cu 2,9 GHz;
 - b. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 55 W (47,4 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,9 GHz și mai mică sau egală cu 3,2 GHz;
 - c. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 40 W (46 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,2 GHz și mai mică sau egală cu 3,7 GHz; sau
 - d. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 20 W (43 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,7 GHz și mai mică sau egală cu 6,8 GHz;

2. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și mai mici sau egale cu 16 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 10 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:
 - a. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 10 W (40 dBm) la orice frecvență mai mare de 6,8 GHz și mai mică sau egală cu 8,5 GHz; sau
 - b. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 5 W (37 dBm) la orice frecvență mai mare de 8,5 GHz și mai mică sau egală cu 16 GHz;
 3. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 3 W (34,77 dBm) la orice frecvență mai mare de 16 GHz și mai mică sau egală cu 31,8 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 10 %;
 4. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 0,1 nW (-70 dBm) la orice frecvență mai mare de 31,8 GHz și mai mică sau egală cu 37 GHz;
 5. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 1 W (30 dBm) la orice frecvență mai mare de 37 GHz și mai mică sau egală cu 43,5 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 10 %;
 6. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 31,62 mW (15 dBm) la orice frecvență mai mare de 43,5 GHz și mai mică sau egală cu 75 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 10 %;
 7. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 10 mW (10 dBm) la orice frecvență mai mare de 75 GHz și mai mică sau egală cu 90 GHz, cu o «lățime de bandă fracționată» mai mare de 5 %; sau
 8. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 0,1 nW (-70 dBm) la orice frecvență mai mare de 90 GHz;
- e. «tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru «dezvoltarea» sau «producția» dispozitivelor și circuitelor electronice, special concepute pentru telecomunicații și care conțin componente fabricate din materiale «superconductoare», special concepute pentru a funcționa la temperaturi situate sub «temperatura critică» a cel puțin unuia dintre constituenții «superconductori» și care au oricare dintre caracteristicile următoare:
1. comutarea în curent pentru circuite digitale care utilizează porți «superconductoare» care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de 10-14 J; sau
 2. selectare de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori ale factorului Q ce depășesc 10 000.”
4. La pagina 175, punctele 6A002.a.1.a-6A002.a.1.d se citesc astfel:
- „a. detectoare optice, după cum urmează:
1. detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială», după cum urmează:

Notă: În sensul 6A002.a.1., detectoarele cu semiconductori includ «rețelele plane focale».

 - a. detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială» având toate caracteristicile următoare:
 1. un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă care depășesc 10 nm, dar nu depășesc 300 nm; și
 2. un răspuns mai mic de 0,1 % în raport cu răspunsul de vârf pentru lungimi de undă ce depășesc 400 nm;
 - b. detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială» având toate caracteristicile următoare:
 1. un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă care depășesc 900 nm, dar nu depășesc 1 200 nm; și
 2. o «constantă de timp» de răspuns mai mică sau egală cu 95 ns;
 - c. detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială» având un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă care depășesc 1 200 nm, dar nu depășesc 30 000 nm;
 - d. «rețele plane focale» «calificate pentru utilizare spațială» având mai mult de 2 048 elemente în fiecare rețea și un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă care depășesc 300 nm, dar nu depășesc 900 nm;”.

5. La paginile 179-180, punctele 6A002.b-6A002.f se citesc astfel:

„b. «senzori de imagine monospectrali» și «senzori de imagine multispectrali», concepuți pentru aplicații de detecție la distanță și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. un câmp de vedere instantaneu (IFOV) mai mic de 200 μ rad (microradiani); sau
2. mențiți să funcționeze în spectrul lungimilor de undă ce depășesc 400 nm, dar nu depășesc 30 000 nm și având toate caracteristicile următoare:
 - a. furnizează date de imagine de ieșire în format digital; și
 - b. având oricare dintre următoarele caracteristici:
 1. «calificate pentru utilizare spațială»; sau
 2. concepuți pentru funcționare aeropurtată, utilizând detectoare, altele decât cele cu siliciu, și având un IFOV mai mic de 2,5 mrad (miliradiani);

Notă: 6A002.b.1. nu supune controlului «senzorii de imagine monospectrali» cu un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă ce depășesc 300 nm, dar nu depășesc 900 nm și care încorporează oricare dintre următoarele tipuri de detectoare care nu sunt «calificate pentru utilizare spațială» sau de «rețele plane focale» care nu sunt «calificate pentru utilizare spațială», după cum urmează:

1. dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD) care nu sunt concepute sau modificate pentru a realiza «multiplicarea sarcinii»; sau
2. dispozitive cu semiconductori complementari din oxid metalic (CMOS) care nu sunt concepute sau modificate pentru a realiza «multiplicarea sarcinii».

c. echipamente de imagine cu «vedere directă» încorporând oricare dintre următoarele elemente:

1. tuburile amplificatoare de imagine menționate la 6A002.a.2.a. sau 6A002.a.2.b.;
2. «rețelele plane focale» menționate la 6A002.a.3; sau
3. detectoarele cu semiconductori menționate la 6A002.a.1.;

Notă tehnică:

Mențiunea «vedere directă» se referă la echipamentele de imagine care prezintă unui observator uman o imagine vizuală fără convertirea acesteia într-un semnal electronic pentru afișarea pe un ecran de televiziune și care nu pot să înregistreze sau să memoreze imaginea fotografic, electronic sau prin orice alte mijloace.

Notă: 6A002.c. nu supune controlului următoarele echipamente, atunci când încorporează alți fotocatozi decât cei cu GaAs sau GaInAs:

- a. sisteme de alarmă în caz de intruziune în unități industriale sau civile, sisteme de control ori de înregistrare a traficului sau a deplasărilor în sectorul industrial;
- b. echipamente medicale;
- c. echipamente industriale folosite pentru inspecția, sortarea sau analizarea proprietăților materialelor;
- d. detectoare de flăcări pentru cuptoare industriale;
- e. echipamente special concepute pentru a fi utilizate în laborator;

d. componente auxiliare speciale pentru senzori optici, după cum urmează:

1. sisteme de răcire criogenice calificate pentru «utilizare spațială»;
2. sisteme de răcire criogenice care nu sunt calificate pentru «utilizare spațială» cu o temperatură a sursei de răcire mai mică de 218 K (-55 °C), după cum urmează:
 - a. cu ciclu închis, cu un timp mediu până la defectare (MTTF) sau cu un timp mediu de bună funcționare (MTBF) de peste 2 500 de ore;
 - b. minirăcitoare Joule-Thomson (JT) cu autoreglare cu diametre de alezare (exterioare) mai mici de 8 mm;
3. fibre de detecție optică fabricate special din punctul de vedere al compoziției sau al structurii, ori modificate prin acoperire, pentru a deveni sensibile la efecte acustice, termice, inerțiale, electromagnetice sau la radiații nucleare;

Notă: 6A002.d.3 nu supune controlului fibrele de detecție optică încapsulate special concepute pentru aplicații de detecție utilizate în operațiuni de foraj.

- e. neutilizate.
- f. «circuite integrate de citire» (read-out integrated circuits, «ROIC») special concepute pentru «rețelele plane focale» menționate la 6A002.a.3.

Notă: 6A002.f. nu supune controlului «circuitele integrate de citire» special concepute pentru aplicații auto civile.

Notă tehnică:

Un «circuit integrat de citire» («ROIC») este un circuit integrat conceput să stea la baza sau să fie conectat la o «rețea plană focală» («FPA») și să fie utilizat pentru citirea (adică extragerea și înregistrarea) semnalelor produse de elementele detectoare. Ca cerință minimă, «ROIC» afișează sarcina elementelor detectoare prin extragerea sarcinii și aplicarea unei funcții de multiplexare într-un mod care păstrează informațiile referitoare la poziția și orientarea spațială relativă a elementelor detectoare pentru prelucrare în interiorul sau în exteriorul «ROIC».

6. La pagina 185, punctele 6A004.a.2-6A004.a.3 se citesc astfel:

- „2. oglinzi monolitice ușoare cu o «densitate echivalentă» medie mai mică de 30 kg/m² și o masă totală de peste 10 kg;

Notă: p6A004.a.2. nu supune controlului oglinzile special concepute pentru a direcționa radiațiile solare pentru instalațiile terestre cu heliostat.

3. structuri ușoare de oglinzi «compozite» sau spongioase cu o «densitate echivalentă» medie mai mică de 30 kg/m² și o masă totală de peste 2 kg;

Notă: 6A004.a.3. nu supune controlului oglinzile special concepute pentru a direcționa radiațiile solare pentru instalațiile terestre cu heliostat.”
